Mikrorezonátory v integrované fotonice



VInovodné struktury s mikrorezonátory (≥ 1990, B. E. Little *et al.*, MIT, Cambridge, USA)





Vlnová délka nebo fáze



Mikrorezonátor v rezonanci

Mikrorezonátor mimo rezonanci





Modelování a charakterizace mikrorezonátorů

"Klasický" spektrální přístup: "mode solver" + metoda vázaných vln

Numerický přístup: FDTD

MIT, 1998, 2D FDTD model



U Twente, NL, 2000 mikroskopický obraz mikrorezonátoru o Ø 50 µm, materiálový systém Si/SiO₂/Si₃N₄

off-resonance



on-resonance







ūfe

Mikrorezonátor jako stavební prvek integrovaných fotonických struktur







Technologické aspekty

Laterální vazba mezi mikrorezonátorem a vlnovodem je velmi kritická:



MIT, Cambridge, 2000 Al_{0,5}Ga_{0,5}As–GaAs systém šířka vlnovodů 0,42–0,62 µm šířka štěrbin 0,18–0,32 µm hloubka leptání 2 µm

Alternativa: vertikální vazba





Optimalizace příčného průřezu mikrorezonátoru pro snížení ztrát vyzařováním z ohybu



Laterální a vertikální vazba mezi µR a vlnovodem

Laterální vazba Jednostupňová litografie kritická vazební štěrbina menší flexibilita 3D vektorové modelování zádoucí



substrát

Vertikální vazba dvoustupňová litografie lepší reprodukovatelnost větší flexibilita 3D vektorové modelování nezbytné

Hybridizace vidů v diskovém rezonátoru



ūfe

Vazba mezi 3D přímým a zakřiveným vlnovodem



Problémy:

- Vazba mezi vedeným (bezeztrátovým) a vytékajícím (vyzařujícím) videm
- Role fázového synchronismu? (proměnná relativní fázová rychlost)
 Přístup: lineární superpozice polí přímého a zakřiveného vlnovodu

 $\mathsf{E}(\mathsf{r}) \approx a_w(z) \mathsf{e}_w(x, y) + a_b[\varphi(z)] \mathsf{e}_b(x, r)$

+ aplikace obecných teorémů, např. reciprocity:

$$\nabla \cdot \left(\mathsf{E}_1 \times \mathsf{H}_2 - \mathsf{E}_2 \times \mathsf{H}_1\right) = i\omega\varepsilon_0 \left(n_1^2 - n_2^2\right)\mathsf{E}_1 \cdot \mathsf{E}_2$$

 $E_1 \dots celkové pole, E_2 = e_w, e_b, pak vynásobení postupně <math>e_w a e_b$, integrace přes plochu *S* s využitím ortogonality. Získáme soustavu diferenciálních rovnic 1. řádu pro $a_w(z) a a_b[\varphi(z)]$ téhož tvaru jako má rovnice vázaných vidů:

$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} a_w(z) \\ a_b(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \kappa_{ww}(z) & \kappa_{wb}(z) \\ \kappa_{bw}(z) & \kappa_{bb}(z) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a_w(z) \\ a_b(z) \end{pmatrix}.$$



Teorie vázaných vln pro 3D horizontálně i vertikálně vázané mikrorezonátory (spolupráce s Uni Twente - Dr. R. Stoffer, Dr.M. Hammer) $z = -24\mu m$ $z = -18\mu m$ $z = -12\mu m$



 $z = -6\mu m$











 $z = 12 \mu m$







 $z = 24 \mu m$



U. Twente + ÚRE, Optics Commun. 2005

Příklady rozložení polí

$$n_{sub} = 1.6$$
, $n_{quide} = 1.7$, $r = 10 \ \mu m$





Přístup zakřiveného vlnovodu

Přístup komplexní frekvence



Experimentální vzorek mikrorezonátorů na bázi Si₃N₄/SiO₂ (Uni Twente)



Detail vazební oblasti





Chování 2D pole pro velké poloměry

Asymptotický rozvoj Hankelovy funkce pro velké argumenty

$$\begin{split} \mathrm{H}_{\nu}^{(1)}(z) &\approx \sqrt{\frac{2}{\pi z}} e^{i(z-\pi\nu/2-\pi/4)}, \ -\pi < \arg z < 2\pi \\ E_{z}(r,\varphi) &\approx D' \sqrt{\frac{1}{k_{0}n_{3}r}} e^{ik_{0}n_{3}r} e^{i\nu\varphi}, \ r \to \infty \end{split}$$

Přístup zakřiveného vlnovodu:

$$k_0 = \frac{2\pi}{\lambda}, \ \nu = \nu' + i\nu''$$

$$E_{z}(r,\varphi) \approx D' \sqrt{\frac{1}{k_{0}n_{3}r}} e^{ik_{0}n_{3}r} e^{i\nu'\varphi} e^{-\nu''\varphi}, \quad r \to \infty$$

Pole vlastního vidu *klesá* pro $r \to \infty$ jako $\frac{1}{\sqrt{k_0 n_3 r}}$



Chování 2D pole pro velké poloměry

Přístup zakřiveného vlnovodu:



Vlnovodné filtry na bázi mikrorezonátorů

Příklad 1: Termoopticky laděný filtr vyšších řádů Filtry 1. až 11. řádu, ø 72 µm SiO₂/Hydex (n_s = 1,45, n_g = 1,7), Ø \approx 50 µm ztráty na čipu 1 ÷ 1,5 dB Little Optics, Inc., PTL, Sept. 2004 (nyní Infinera)



Termoopticky laděné spektrální charakteristiky filtru 5. řádu, Δf = 25 GHz



"Demonstrátor" projektu NAIS

Rekonfigurovatelný demultiplexor s termoopticky laděnými mikrorezonátory (Realizace: University of Twente, NL, systémové testy: Nortel, UK)





Využití nelineárních optických efektů ve fotonických strukturách s mikrorezonátory



Nelineární šíření optického záření v mikrorezonátoru: Kerrovská nelinearita -> automodulace fáze



$$a_{2} = a_{1}be^{i\phi_{L}}e^{i\phi_{NL}}$$

$$\phi_{NL} = -\gamma \left|a_{1}\right|^{2} \left(1 - b^{2}\right) / \left(2\ln b\right)$$

... nelineární změna fáze (automodulace)



Jednoduchý model optického spínání v mikrorezonátoru





Spínač využívající křížovou fázovou modulaci v mikrorezonátoru



Parametry:

Materiál: Křemík na SiO₂ Průměr mikrorezonátoru: 10 µm Rozměry vlnovodů: 300×400 nm Nosná vln.délka signálu: 1545 nm Vlnová délka čerpací ho ipulsu: 1577 nm Vstupní impuls: gaussovský, $t_s \approx 5$ ps Čerpací impuls: gaussovský, $t_p \approx 5$ ps Špičkový čerpací výkon: $P_p \approx 2.5$ W

Interakce je popsaná dvojicí vázaných nelineárních rovnic pro dva (spektrálně se nepřekrývající) impulsy:

$$\frac{\partial u_{s}(z,t)}{\partial z} - i\beta_{0,s}u_{s} + \beta_{1,s}\frac{\partial u_{s}}{\partial t} + i\frac{\beta_{2,s}}{2}\frac{\partial^{2}u_{s}}{\partial t^{2}} - \frac{\beta_{3,s}}{6}\frac{\partial^{3}u_{s}}{\partial t^{3}} + \dots = i\gamma_{0,s}u_{s}\left(\left|u_{s}\right|^{2} + 2\left|u_{p}\right|^{2}\right) \quad \dots \text{ signal}$$

$$\frac{\partial u_{p}(z,t)}{\partial z} - i\beta_{0,p}u_{p} + \beta_{1,p}\frac{\partial u_{p}}{\partial t} + i\frac{\beta_{2,p}}{2}\frac{\partial^{2}u_{p}}{\partial t^{2}} - \frac{\beta_{3,p}}{6}\frac{\partial^{3}u_{p}}{\partial t^{3}} + \dots = i\gamma_{0,p}u_{p}\left(2\left|u_{s}\right|^{2} + \left|u_{p}\right|^{2}\right) \quad \dots \text{ cerpanis}$$



Nelineární optické přepínání: časová závislost



Výhody a nevýhody vlnovodných struktur s mikrorezonátory

Výhody:

- Relativně velká variabilita realizovatelných funkcí – spektrální filtr, modulátor, přepínač, laser(?), …
- Technologická homogenita prvků s různými funkcemi
- Malé rozměry stavebních bloků (řádu 10 µm)

Nevýhody:

- Vysoká technologická náročnost
- Návrh a modelování vyžaduje nové metody (3D, všesměrové šíření)
- Obtížnost účinné vazby na vláknové vlnovody
- Omezené technické parametry (šířka pásma filtru, mezní frekvence modulátoru, ...)

Dnes patrně nejperspektivnější technologie pro "large-scale photonic integration"

